

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук

объявляет конкурс на замещение вакантной должности

научного сотрудника, кандидата наук

в лаборатории полупроводниковой люминесценции и инжекционных излучателей

Вакансия VAC 105386

Тематика исследований

Экспериментальные исследования оптических характеристик полупроводниковых гетероструктур, прототипирование устройств интегральной фотоники методом прямой литографии сфокусированным ионным пучком.

Трудовая деятельность

- Исследование влияния процессов ионно-лучевого травления на образование радиационных дефектов в приборных полупроводниковых гетероструктурах
- Изучение влияния процесса ионно-лучевого травления на фотолюминесцентные характеристики приборных полупроводниковых гетероструктур
- Поиск методов борьбы с радиационными дефектами, возникающими в полупроводниковых гетероструктурах в процессе прямой ионно-лучевой литографии сфокусированным ионным пучком
- Подготовка и проведение исследований оптических характеристик приборных полупроводниковых гетероструктур
- Анализ полученных экспериментальных данных
- Подготовка статей для публикации в научных журналах, а также представление полученных результатов на конференциях
- Выполнение научных задач и подготовка отчетов по проектам фундаментальных и прикладных исследований

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя заведующим лабораторией.

Требования к претенденту

- инженер по специальности «Приборы и системы лучевой энергетики»
- Кандидат технических наук по специальности 05.27.03 - квантовая электроника
- Опыт научной деятельности: не менее 5 лет
- Наличие не менее 15 публикаций WoS/Scopus в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет, в том числе наличие публикаций в высокорейтинговых журналах, входящих в квартиль Q2
- Опыт разработки исследовательских стендов и программного обеспечения для проведения экспериментальных исследований полупроводниковых структур, опыт работы и умение организации технологических процессов на установке прямой литографии сфокусированным ионным пучком, навыки прототипирования фотонных устройств методами прямой ионно-лучевой литографии, опыт работы по исследованию полупроводниковых гетероструктур методами атомно-силовой микроскопии, растровой электронной и ионной микроскопии, опыт работы на установках измерения фотолюминесцентных и электролюминесцентных характеристик полупроводниковых гетероструктур.

- Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя.
-
- ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 31 312 руб.
- СТАВКА: 1.0
- СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ: 15 000 руб.
- Срок трудового договора – 5 лет
-
- К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы:
 - копии документов о высшем профессиональном образовании;
 - копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
 - сведения о научной работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса,
- список публикаций
- Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, ученому секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок:
- (812) 297 22 45
-